



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HBD241C

对应国外型号
BD241C

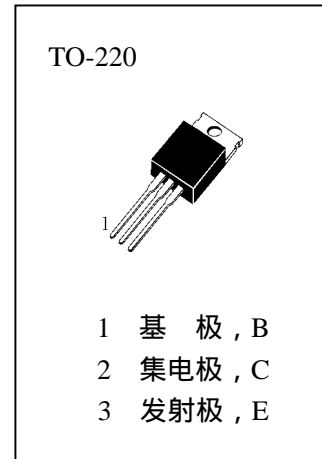
主要用途

功率放大、开关作用

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极耗散功率 ($T_c=25$)	40W
V_{CER}	——集电极—发射极电压.....	115V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	100V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	5V
I_C	——集电极电流.....	3A
I_B	——基极电流.....	1A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$V_{CE0} (SUS)$	集电极—发射极维持电压	100			V	$I_C=30mA, I_B=0$
I_{CE0}	集电极—发射极截止电流			300	μA	$V_{CE}=60V, I_B=0$
I_{CES}	集电极—发射极电流			200	μA	$V_{CE}=100V, V_{BE}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
$H_{FE} (1)$	直流电流增益	25				$V_{CE}=4V, I_C=1A$
$H_{FE} (2)$		10				$V_{CE}=4V, I_C=3A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=3A, I_B=0.6A$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			1.8	V	$V_{CE}=4V, I_C=3A$